УДК 539.21: [539.216.25+681.51.015:681.3]

СУБСТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМАХ Ag-Ni И Ag-Cu

© 2013 А.В.Бугаков, С.В.Бурова

Воронежский государственный технический университет, Московский пр., 14, 394026 Воронеж, Россия e-mail: abugakov2011@yandex.ru

Поступила в редакцию 09.10.2013 г.

Аннотация. Проведено исследование расслоения эпитаксиальных двухкомпонентных пленочных систем Ag-Ni и Ag-Cu. Показано, что образующиеся зерна либо имеют параллельную ориентацию с матрицей, либо представляют собой сдвойникованные частицы. Появление последних обусловлено выделением Cu или Ni на внутренних плоскостях {111}Ag с образованием низкоэнергетических межфазных границ и последующим двойникованием для лучшего согласования второй фазы с Ag-матрицей.

Ключевые слова: двухкомпонентные пленочные системы Ag-Ni и Ag-Cu, расслоение, низкоэнергетические межфазные границы, сдвойникованные частицы, ориентационные соотношения.

введение

Актуальность темы исследования обусловлена двумя факторами. Во-первых, наноструктурные двухкомпонентные системы, в том числе Ag — Ni, подробно исследовали на проявление гигантского магниторезистивного эффекта [1]. Во-вторых, учитывая высокую дисперсность пленок, представляется актуальным исследование процессов старения.

Целью работы является исследование структурной самоорганизации фаз в процессе расслоения вакуумных конденсатов систем Ag — Cu и Ag — Ni, анализ конечной структуры, ориентации фаз и закономерностей сопряжения их между собой.

Выбор систем обусловлен полной взаимной нерастворимостью компонентов, причем для системы Ag — Ni характерна нерастворимость компонентов и в жидком состоянии, а также близость параметров решеток Ni и Cu (несоответствие несколько процентов), что позволяет ожидать одинаковых закономерностей сопряжения фаз.

Тонкие пленки готовили следующим образом. Из двух изолированных вольфрамовых испарителей одновременно термическим напылением наносили Ag и Cu (Ni) на скол (100) NaCl. Точный состав пленок особого значения не имел и приблизительно оценивался по скорости напыления компонентов. Толщина пленок составляла 60—70 нм.

Для анализа ориентационных соотношений при расслоении фаз необходимо получить ориентированные пленки, поэтому были определены режимы напыления, обеспечивающие эпитаксиальный рост. Исследование показало, что эпитаксиальный рост происходит при концентрациях Си до 10% и свыше 40%. Была определена температура подложки, обеспечивающая строгую ориентацию пленок для различных составов.

Пленки состава Ag — (40-60)%Cu (Ni) достаточно подробно исследовали в работах [2, 3], основные результаты которых следующие. Строго ориентированные пленки Ag — (40-60)%Cu вырастали только при температуре подложки T_n ~ 520 К. Повышение и понижение T_n приводит к ухудшению ориентированного роста. Одновременно с ухудшением ориентации пленок Ag — Cu при повышении T_n наблюдается увеличение размера зерен Ag и Cu и прорастание их на всю толщину пленки.

В ориентированных пленках Ag и Cu — фазы имеют взаимно параллельную ориентацию (100). Электронограммы пленок показали наличие отражений двойной дифракции, которые возникают в результате многократного отражения электронного луча на параллельных отражающих плоскостях Ag и Cu и свидетельствуют о слоистой структуре Ag — Cu пленки.

Исследование элементного состава пленок по глубине, проведенное методом Оже-спектроскопии [2], показало, что состав пленок по глубине практически не изменяется. Это свидетельствует о том, что нет разделения фаз Ag и Cu на два слоя и, следовательно, происходит расслоение фаз в направлении роста. В результате образуется высокодисперсная смесь, представляющая собой нерегулярные слоистые композиции из чередующихся очень тонких, диаметром до 10 нм, взаимно ориентированных пластинок обеих фаз. Таким образом, происходит автомодуляция по составу в направлении роста при сохранении в целом высокодисперсной структуры. Аналогичная субструктура формируется и в пленках системы Ag—Ni ($T_n \sim 625$ K).

В работе [3] предложена модель диффузионного расслоения фаз при росте пленок двухкомпонентных металлических систем с ограниченной взаимной растворимостью, объясняющая наблюдаемую субструктуру пленок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В предлагаемой работе исследованы пленки с малой концентрацией Си и расслоение фаз при отжиге исходных пленок.

Отжиг ориентированных Ag — (40-60)%Сuпленок при температуре 900 К приводил к большему расслоению фаз путем коалесценции высокодисперсных зерен и выделению крупных кристаллитов Си в (100) Ag-матрице. На рис. 1 представлены электронограмма (*a*) и микрофотография (*б*) отожженной пленки. Как видно из электронограммы, плоскостная ориентация Ag и Cu сохраняется, но происходит отклонение азимутальной ориентации части зерен Cu от параллельной Ag в пределах $\pm 15^{\circ}$. Отсутствие отражений двойной дифракции свидетельствует о прорастании зерен второй фазы на всю толщину пленки. Средний размер зерен Си составлял ~ 1 мкм. При большем содержании Си отжиг приводит к полному вытеснению серебра на поверхность меди.

В пленках с концентрацией Си до 10% слоистая структура не выявляется. На рис. 2*a* приведена микрофотография начальной стадии расслоения фаз. При отжиге таких образцов помимо монокристаллических зерен Си, ориентированных параллельно Аg, появляются выделения меди в виде многократно сдвойникованных частиц. На рис. 2*б*, *в*, *г* приведены типичные микрофотографии участков, содержащих такие частицы. Аналогичная ситуация наблюдается и в системе Ag — Ni (рис. 3).

Исследуемые системы обладают достаточно большим несоответствием (~14%), и в них существуют специальные ориентационные соотношения, обеспечивающие более низкую энергию межфазной границы, чем параллельная ориентация. Реализация параллельной ориентации тонких чередующихся слоев Ag и Cu (Ni) может быть обусловлена действием нескольких факторов. Вопервых, это ориентирующее действие подложки; во-вторых, сближение параметров решеток вследствие возможной в тонких пленках взаимной растворимости компонентов; в-третьих, как показано в работе [4] методами компьютерного моделирования, чередование тонких слоев может приводить к уменьшению энергии границ раздела, и параллельная ориентация будет выгоднее, чем реализация специальных межфазных границ. Эти факторы, наряду с кинетикой диффузионного расслоения,



Рис. 1. Электронограмма (a) и структура (б) отожженных пленок Ag-Cu

А. В. БУГАКОВ, С. В. БУРОВА



Рис. 2. Начальная стадия расслоения фаз (*a*), многократно сдвойникованные частицы в системе Ag-Cu (*б*, *в*, *г*)

и приводят к эпитаксиальному росту слоистой структуры. При отжиге коалесценция зерен сохраняет параллельную ориентацию.

При малых концентрациях меди перечисленные выше факторы уже не работают, и происходит выделение меди на плоскостях {111} Ag. Как показывают экспериментальные данные по ориентированной кристаллизации [5], моделирование границ раздела [6], анализ кристаллографии сопряжения решеток при отношении параметров кристаллических решеток $\alpha = 1.156$ (для системы Ag — Cu $\alpha =$ 1.130, Ag — Ni — $\alpha = 1.159$) наиболее выгодным является сопряжение фаз в ориентационном соотношении:

$$(100), <011> Cu \parallel (111), <110> Ag.$$
 (1)

Схема сопряжения решеток приведена на рис. 4*a*. Эта ориентация обеспечивает хорошее согласование плоскостей (111) Си и (001) Ад на межфазной границе, как показано на рис. 4*б*. При общей плоскостной ориентации пленки (001) и малых концентрациях Си выделение меди происходит на внутренних плоскостях (111) Ад-матрицы, что равнозначно объемной эпитаксии (эндотаксии). Этому способствует известный факт, что многие фазовые превращения и переходы начинаются с плоскости (111) как наиболее плотноупакованной. Кроме того, в процессе отжига в Ад-матрице появляется большое количество дефектов упаковки, которые могут служить центрами выделения меди.

При реализации соотношения (1) возможны две плоскостные ориентации Си:

$$(001), [\overline{1}110] \operatorname{Ag} \| (111), [01\overline{1}] \operatorname{Cu}$$
 (2)

и близкая к

$$(001), [\overline{1}10] \text{ Ag } \| (3\overline{4}1), [014] \text{ Cu.}$$
 (3)

При зарождении на пересекающихся плоскостях {111} Ад соотношение (2) приводит к 90-граСУБСТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМАХ Ag-Ni И Ag-Cu



Рис. 3. Многократно сдвойникованные частицы в системе Ag-Ni (a-г)



Рис. 4. Сопряжение решеток (*a*) по ориентационному соотношению (1) и согласование плоскостей на межфазной границе (МГ) (*б*)

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 15, № 4, 2013



Рис. 5. Схемы сдвойникованных частиц Си в Ад-матрице

дусной границе зерен (111) Cu, которая не является специальной и обладает повышенной энергией. При ориентации (3) два зерна Си (зерна 1 и 2 на рис. 2б и схема на рис. 5) разделяются двойниковой границей по плоскости (111), перпендикулярной поверхности пленки, что обеспечивает малую энергию системы. Третьей плоскостью, ограняющей зерна 1 и 2, также является плоскость (111), наклонная к поверхности пленки. Дальнейший рост Си-выделения приводит к двойникованию по этой плоскости. В результате образуются два новых зерна (3 и 4), находящихся в двойниковой ориентации относительно зерен 1 и 2. Их плоскостная ориентация — (105). Образование новых зерен, возможно, обусловлено тем, что их ориентация ближе к ориентации исходной пленки (001).

Огранка этих зерен определяется плотноупакованными плоскостями Си и их сопряжением с Ag — матрицей. Плоскость (100) Си (след на (105) — [010]) почти перпендикулярна поверхности и почти параллельна {100} Ag (отклонение ~11°), т. е. возникает граница, близкая к параллельной. Плоскости (111), (111) и (110) (соответствующие следы — [541], [561], [551], см. зерно 3 на рис. 5*a*) могут приводить к межфазной границе, близкой к (110) Ag|| (110) Си, также с небольшими углами наклона и поворота (до 10°).

В некоторых случаях возможно двойникование по плоскостям (111) зерен 3 и 4 с образованием нового зерна (5 на рис. 26 и рис. 56) с ориентацией (105). При этом угловое несоответствие между зернами 3 и 5 составляет ~ 5°. На рис. 26 видны следы дислокаций, компенсирующих это отклонение от точной ориентации, период этих дислокаций примерно соответствует этому отклонению. Новое зерно граничит с Ад-матрицей также плоскостью (100), ее след [010] практически параллелен <100> Ад, т. е. образуется граница с небольшим (~11°) наклоном.

Образование выделений в виде сдвойникованных частиц, видимо, характерно не только при малых концентрациях Сu. Отклонение азимутальной ориентации может быть вызвано переходом ориентации (105) в (001) при увеличении размера выделения. Выгодность такого перехода может быть связана с уменьшением энергии при исчезновении границ зерен внутри выделения.

выводы

Расслоение двухкомпонентных пленочных систем Ag-Cu и Ag-Ni при отжиге приводит к образованию зерен Cu или Ni в Ag-матрице, прорастающих на всю толщину пленки. В пленках с содержанием Cu или Ni 40—60 % эти зерна (размер — до 1мкм) находятся в параллельной ориентации с Ag-матрицей, что обусловлено мелкодисперсной слоистой структурой исходной эпитаксиальной пленки. При концентрации Cu или Ni до 10% выделения второй фазы представляют собой сдвойникованные частицы размером до 0.1 мкм, образующие низкоэнергетические межфазные границы с матрицей. Двойникование первого и второго порядка обеспечивает лучшее согласование второй фазы с матрицей.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 11-08-01257-а. СУБСТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМАХ Ag-Ni И Ag-Cu

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Pogorily A., Kravets A., Shypil E. et al.* // Thin Solid Films. 2003. V. 423. Iss. 2. P. 218.

2. Иевлев В. М., Бурова С. В., Трусов Л. И. и др. // ФММ. 1986. Т. 62. С. 412.

3. Иевлев В. М., Шведов Е. В., Ампилогов В. П. и др. // ФММ. 2000. Т. 90. № 2. С. 72.

Бугаков Александр Викторович — профессор, кафедра физики ВГТУ; e-mail: abugakov2011@yandex.ru

Бурова Светлана Васильевна — доцент, кафедра физики ВГТУ.

4. *Иевлев В. М., Бугаков А. В., Гапонов А. А.* // Вестник ВГТУ. Сер. «Материаловедение». 2000. Вып. 1.8. С. 61.

5. Иевлев В. М., Бугаков А. В., Иевлев В. П. // ФММ. 1980. Т. 50. С. 427.

6. *Бугаков А. В., Иевлев В. М.* // Поверхность. Физика, химия, механика. 1994. № 12. С. 112.

Bugakov Alexander V. — Professor of Physic Department, Voronezh State Technical University; e-mail: abuga-kov2011@yandex.ru

Burova Svetlana V. — Associate Professor of Physic Department, Voronezh State Technical University